

## SMD-N25626E

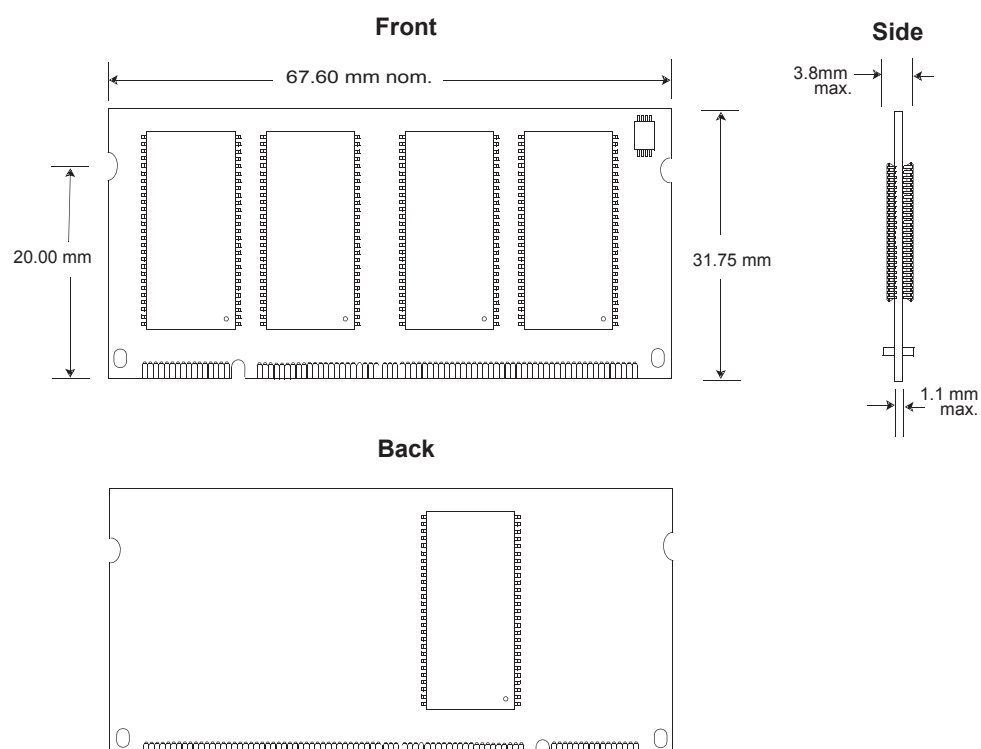
### DESCRIPTION

SMD - N 2 5 6 2 6 Eは、5 1 2 MビットDDR・DRAM (32M x 16bit) を5個搭載した3 2 M x 7 2 ビットDDR・DRAMモジュールです。

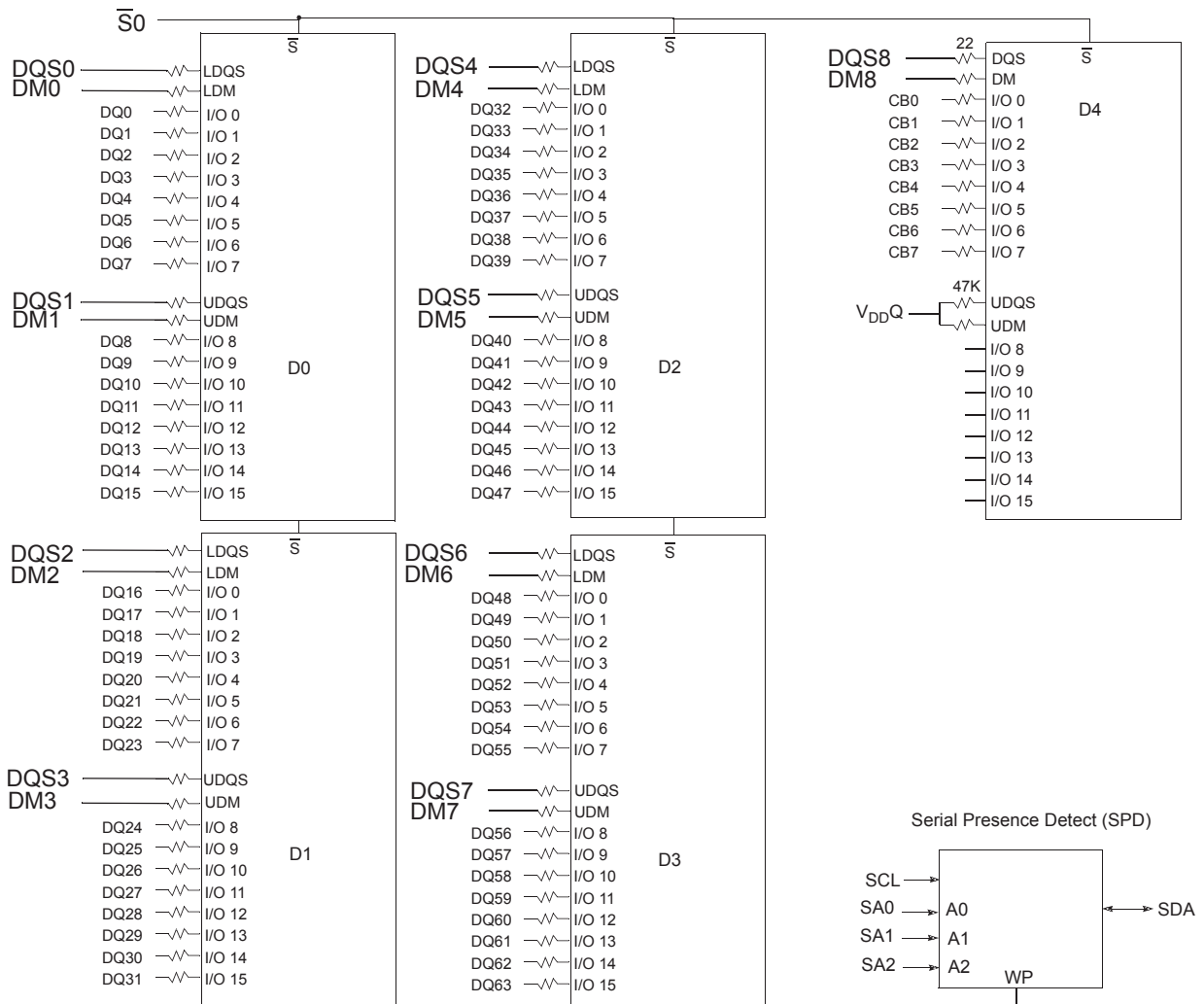
### FEATURES

- ・ 200ピン・デュアル・インライン・メモリ・モジュール  
(ピン・ピッチ 0.60mm)
- ・ 基板高 1.25 "(31.75 mm)
- ・ CL - tRCD - tRP=3 - 3 - 3 (PC3200) 2.5 - 3 - 3 (PC2700 / PC2100)
- ・ 2.6V ± 0.1V 単一電源 (PC3200) 2.5V ± 0.2V (PC2700 / PC2100)
- ・ 8, 192リフレッシュ / 64ms
- ・ SSTL\_2コンパチブル
- ・ /CASレイテンシー3.0, 2.5クロックプログラマブル (PC3200)
- ・ " 2.5, 2.0クロックプログラマブル (PC2700 / PC2100)
- ・ 1バンク構成
- ・ アンバッファードタイプ
- ・ シリアルPD
- ・ 接続端子: 電解金メッキ (t 0.76 μm)
- ・ ECC

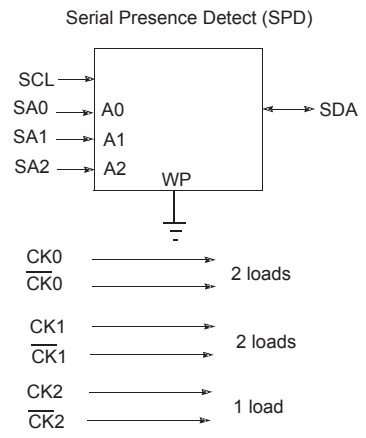
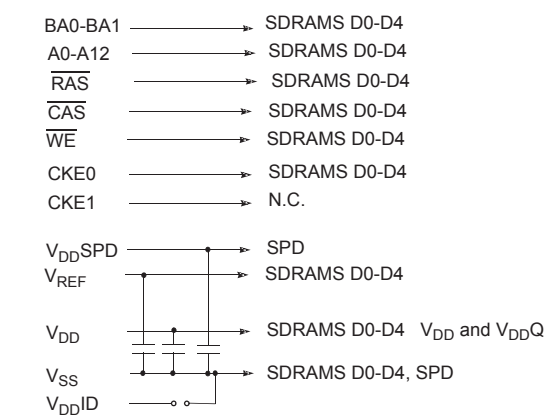
### Outline Drawing



**Functional Block Diagram**



#Unless otherwise noted, resistor values are 22 ohms  $\pm$  5%



Note: DQ wiring may differ from that described in this drawing; however DQ/DM/DQS relationships are maintained as shown.  
 $V_{DDID}$  strap connections:  
 (for memory device  $V_{DD}$ ,  $V_{DDQ}$ )  
 Strap out (open):  $V_{DD} = V_{DDQ}$   
 Strap in (closed):  $V_{DD} \neq V_{DDQ}$